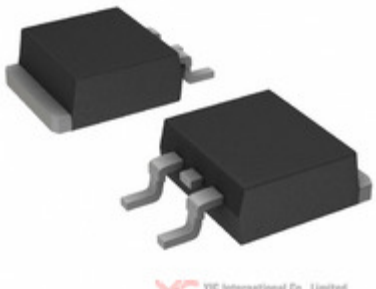
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> UGB12JT3E3/81</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Semiconductor - Diodes Division</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> DIODE GEN PURP 600V 12A TO263AB</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">1.UGB12JT3E3/81.pdf</a>  <a href="#">2.UGB12JT3E3/81.pdf</a></p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>









Spezifikationen

Teilenummer	UGB12JT3E3/81
Hersteller	Vishay / Semiconductor - Diodes Division
Beschreibung	DIODE GEN PURP 600V 12A TO263AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.75V @ 12A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	600V
Supplier Device-Gehäuse	TO-263AB
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	-
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	50ns
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur - Anschluss	-55°C ~ 150°C
Befestigungsart	Surface Mount
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	30µA @ 600V
Strom - Richt (Io)	12A
Kapazität @ Vr, F	-

UGB12JT3E3/81 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, UGB12JT3E3/81-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, UGB12JT3E3/81 Vishay / Semiconductor - Diodes Division mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ UGB12JT3E3/81 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>UGB12JT3E3/45</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 600V 12A TO263AB</p>	 <p><b>UGB12JT-E3/81</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 600V 12A TO263AB</p>	 <p><b>UGB15JT</b> VISHAY UGB15JT VISHAY</p>	 <p><b>UGB12JT3E3/45</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 600V 12A TO263AB</p>
 <p><b>UGB15JT-E3/81</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 600V 15A TO263AB</p>	 <p><b>UGB12JT3E3/81</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 600V 12A TO263AB</p>	 <p><b>UGB12JT-E3/81</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 600V 12A TO263AB</p>	 <p><b>UGB18ACT-E3/45</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE ARRAY GP 50V 18A TO263AB</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

UGB12JT3E3/81 Vishay / Semiconductor - Diodes Division	UGB12JT3E3/81 Datenblatt	UGB12JT3E3/81-Datenblätter	UGB12JT3E3/81 PDF	Vishay / Semiconductor - Diodes Division UGB12JT3E3/81
UGB12JT3E3/81 Electronic	UGB12JT3E3/81-Komponenten	UGB12JT3E3/81-Verteiler	UGB12JT3E3/81-Bild	UGB12JT3E3/81-Teil
UGB12JT3E3/81 Preis	UGB12JT3E3/81 Hersteller	UGB12JT3E3/81 Bild	UGB12JT3E3/81 Aktie	UGB12JT3E3/81 Inventar
UGB12JT3E3/81 Neu	UGB12JT3E3/81 Original	UGB12JT3E3/81 garantiert	UGB12JT3E3/81 RFQ	UGB12JT3E3/81 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited